



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

先进材料与纳米科技学院
School of Advanced Materials and Nanotechnology



- [首页](#)
- [学院概况](#)
 - [概述](#)
 - [历史前沿](#)
 - [现任领导](#)
 - [院委员会](#)
- [新闻公告](#)
 - [新闻动态](#)
 - [通知公告](#)
 - [办事指南](#)
 - [资料下载](#)
- [师资队伍](#)
 - [概述](#)
 - [师资队伍](#)
 - [团队建设](#)
- [科学研究](#)
 - [科研方向](#)
 - [科研平台](#)
 - [科研成果](#)
 - [科研获奖](#)
 - [学科动态](#)
- [教育教学](#)
 -

[本科生](#)

- [概述](#)
- [专业介绍](#)
- [教学改革](#)
- [精品课程](#)
- [教务通知](#)
- [科技竞赛](#)
- [教学安排](#)
- [考试安排](#)
- [获奖情况](#)

◦

[研究生](#)

- [专业介绍](#)
- [博士生导师](#)
- [硕士生导师](#)
- [科技竞赛](#)
- [获奖情况](#)

◦

[实验中心](#)

- [化学实验中心](#)

- [合作交流](#)
 - [概述](#)
 - [学术交流](#)
 - [科研合作](#)
- [党建工作](#)
 - [党团建设](#)
 - [基层动态](#)
 - [党建专题](#)
- [招生就业](#)
 -

[本科生](#)

- [招生信息](#)
- [就业信息](#)
- [就业情况](#)

◦

[研究生](#)

- [招生信息](#)
- [就业信息](#)
- [就业情况](#)

- [学生天地](#)
 - [概述](#)
 - [学生社团](#)
 - [校园活动](#)
 - [奖助学金](#)
 - [优秀学生](#)
- [文件下载](#)
 - [人事行政](#)
 - [本科教学](#)
 - [研究生培养](#)
 - [学科科研](#)
 - [实验预约](#)
 - [财务报销单](#)
 - [固定资产管理](#)
- [联系我们](#)
 - [电话电邮](#)
 - [邮寄地址](#)
 - [来访路线](#)



在这里搜索...

搜索

当前位置:[主页](#) > [科学研究](#) > [科研成果](#) >

专利

时间:2014-12-11 13:41 点击: 3558 次

已授权代表性专利：共 14 项，					
序号	专利名称	专利授权国	专利号	授权公告口	排序
1	AlGaIn/GaN绝缘栅高电子迁移率晶体管的制作方法	中国	ZL200910218717.2	2011.12.07	
2	AlGaIn/GaN高电子迁移率晶体管及其制作方法	中国	ZL201010120734.5	2011.10.19	
3	叠栅SiC-MIS电容的制作方法	中国	ZL201210118317.6	2014.07.09	
4	深亚微米栅长AlGaIn/GaN HEMT制作方法	中国	ZL201010120734.5	2013.04.03	
5	基于SiC衬底的AlGaIn基多量子阱uv-LED 器件及制作方法	中国	ZL200910021761.4	2012.05.09	
6	全透明AlGaIn/GaN高电子迁移率晶体管及其制作方法	中国	ZL201010013536.9	2011.08.24	
7	AlGaIn基蓝宝石衬底的紫外LED器件的制作方法	中国	ZL200910021793.4	2011.04.06	
8	SiC衬底上的多量子阱紫外LED器件及制作方法	中国	ZL200910021764.8	2011.04.06	
9	AlGaIn基SiC衬底的紫外LED 制作方法	中国	ZL200910021778.X	2010.12.01	

10	蓝宝石衬底上的多量子阱紫外LED器件的制作方法	中国	ZL200910021779.4	2010.12.01	
11	基于蓝宝石衬底的AlGaIn基多量子阱uv-LED器件的制作方法	中国	ZL200910021794.9	2010.08.25	
12	基于GaN的MIS栅增强型HEMT器件及制作方法	中国	ZL201210131041.5	2014.08.20	
13	GaN基的MS栅增强型高电子迁移率晶体管及制作方法	中国	ZL201210132145.8	2014.08.20	
14	阶梯型凹槽栅高电子迁移率晶体管	中国	ZL201110001068.8	2012.07.25	
尚未授权专利: 共 4 项					
序号	专利名称	专利申请国	申请号	专利申请日	排序
1	高介电损耗钛硅碳粉体微波吸收剂的制备方法	中国	201410571175.8	2014	
2	一种荧光增强型IR-780近红外介孔硅纳米探针的制备方法	中国	201410289402.8	2014	
3	具有抗体介导的光磁双模态介孔硅纳米颗粒的制备方法	中国	201410289389.6	2014	
4	一种单斜相四面体状钽酸铋晶体的制备方法	中国	201310277825.3	2013	
5	晶体管晶格形变导致性能退化的测试装置及方法	中国	201210434249.4	2012.10.19	
6	离子注入的一维电子气GaN基HEMT器件及制备方法	中国	201310279945.7	2013.07.04	
7	基于刻蚀的一维电子气GaN基HEMT器件及制备方法	中国	201310280216.3	2013.07.04	
8	选区外延的一维电子气GaN基HEMT器件及制备方法	中国	201310280177.7	2013.07.04	

上一篇: [发表论文](#)

下一篇: [科研成果概述](#)

Copyright © 2013-2017 西安电子科技大学先进材料与纳米科技学院 版权所有

陕西省西安市长安区西沣路兴隆段266号西安电子科技大学南校区G楼一层 邮编: 710126 电话: 029-81891149

[电子工程学院网络信息中心](#) 制作维护 